

《GaN研究コンソーシアム 第2回研究会》
「結晶の革新が生み出す Society 5.0 へのインパクト
— 完全結晶はデバイスをどう変えていくか —」

平成 29 年 5 月
GaN研究コンソーシアム事務局

GaN研究コンソーシアムは、産学官の各会員機関が組織の壁を越え共創するオープンイノベーションの場を構築し、我が国の持続的発展と各機関の成長に貢献することを理念としています。

第2回研究会では、会員様からの要望が強かった、結晶の改善がデバイス特性に与える影響について議論できる機会を設けます。まずは、昨今の結晶成長技術・欠陥に対する理解の進捗について、研究の最前線の方からご紹介をいただきます。

次いで、一步先に実用化フェーズに入っているSiCの事例から、GaNデバイスの実用化過程でも直面するであろう課題と克服方向について抽出します。GaNの研究開発例を紹介いただいた後、パネルディスカッションの中で結晶の改善がデバイス特性をどこまで改善できるかについて議論いたします。

みなさまの積極的なご参加をお待ちしております。

◇開催日時

2017年 7月7日（金） 13:00～17:20

◇開催場所

名古屋大学 ES総合館 1階ES会議室

(<http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/congre.html>)

◇講演プログラム

13:00～13:10	開催挨拶	天野 浩 名古屋大学
13:10～13:50	低コストGaNウェハの実現に向けて ～新規気相成長法による高速成長～	中村 大輔 豊田中央研究所
13:50～14:30	結晶欠陥の検出とその特徴	石川 由加里 (一財) ファインセラミックスセンター
コーヒーブレイク		
14:50～15:30	高信頼SiCパワーデバイス実現への挑戦 ～SiCウェハの現状と課題から～	先崎 純寿 産業技術総合研究所
15:30～16:10	GaN結晶 vs GaNデバイスの特性	加地 徹 名古屋大学
休 憩		
16:20～17:20	《パネルディスカッション》 結晶の改善は デバイス特性をどこまで改善するか？	講演者の皆様 【司会】加地 徹

◇対象者 原則としてGaN研究コンソーシアムの会員である機関に所属する方

◇定員 70名

◇募集期間 2017年6月末まで

(応募者が上記定員に達した段階で募集を締め切ります)

◇参加費用 [GaN研究コンソーシアムの会員機関] 無料

[GaN研究コンソーシアムの会員でない機関] 1万円/人

(注:会員機関の参加を優先し、定員の範囲内で参加を認めます)

研究会終了後に懇親会を開催いたします。
ぜひ、こちらもご参加ください。

◆懇親会参加費；3000円

◆会場；研究会の会場隣り「シェ ジロー」<http://chezjiroud.jp/>

参加申し込み方法

下記事務局に、電子メールでご連絡ください。

申し込みの際は、

- ① 参加者氏名 ② 所属機関 ③ 職業(学生または役職) ④ 年齢 ⑤ 電話番号とメールアドレス
⑥ 懇親会への出欠

——の6点を明記してください。

場所・時間等の詳細は、参加登録後にメールでご連絡します。

個人情報をご研究会の参加登録以外の目的で使用すること、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】

GaN研究コンソーシアム/研究会事務局

E-MAIL: gan-con@aip.nagoya-u.ac.jp (電話 052-747-6584)

【事務局メンバー】

名古屋大学

研究協力部 社会連携課：菱川 佳織、加藤 史征
学術研究・産学連携推進本部 企画戦略グループ：
佐藤 浩哉、笹岡 千秋、山口 淳、高橋 麻美